# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

59108119

**PUBLICATION DATE** 

22-06-84

APPLICATION DATE

13-12-82

APPLICATION NUMBER

57216834

APPLICANT: HITACHI LTD;

INVENTOR:

MATSUMOTO MASAKAZU;

INT.CL.

G05D 23/19 H01L 21/205 H01L 21/31

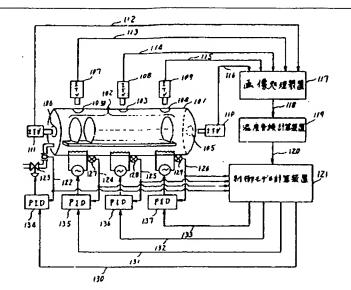
H01L 21/66

TITLE

: ON-LINE MEASURING AND

CONTROLLING SYSTEM OF FURNACE

**TEMPERATURE** 



ABSTRACT:

PURPOSE: To make the internal temperature of an object to be heated in a furnace close to an objective temperature by estimating the furnace temperature from picture information obtained from ITVs and inputting the estimated value to a control model.

CONSTITUTION: The ITVs 107~111 are fitted to windows 1030, 103~106 of the furnace 101. The ITVs 107~111 sends the distribution data 112~116 of the furnace temperature to a picture processor 117, which estimates the external temperature of the object in the furnace and applies the estimated temperature information 118 to a temperature conversion calculating device 119. The device 119 applies the estimated temperature information 118 to a control model computer 121 as the temperature input information 120 necessary for a control model. The control model computer 121 calculates the temperature inside the object to be heated by using the temperature distribution estimating model of the object 102 to be heated and controls the flow rate of feeding gas, the heating temperature of a heater, etc. by a closed loop. Consequently, the dispersion of products can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

### (9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公開特許公報 (A)

6851-5F

昭59-108119

(i) Int. Cl.<sup>3</sup>
 (i) G 05 D 23/19
 (i) H 01 L 21/205
 (i) 21/31
 (i) 21/66

識別記号 庁内整理番号 2117--5H 7739--5F 7739--5F

❸公開 昭和59年(1984)6月22日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 7 頁)

### **匈**炉内温度オンライン計測・制御方式

②特

願 昭57-216834

❷出

(昭57(1982)12月13日

⑫発 明 者 松本邦顕

川崎市麻生区王禅寺1099番地株 式会社日立製作所システム開発 研究所内

⑫発 明 者 松葉育雄

川崎市麻生区王禅寺1099番地株

式会社日立製作所システム開発 研究所内

⑫発 明 者 松本雅一

下松市東豊井794番地株式会社 日立製作所笠戸工場内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

砂代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 報

発明の名称 炉内晶度オンライン計劃・制御方式

#### 特許増求の範囲

- 1. 加熱炉内における被加熱物の内部温度の目標 退値制御方式において、加熱炉ののぞき窓にに設 酸された機像手段で得られた熱スペクトル情報 にもとづき被加熱物の外部温度を推定し、 膝椎 定された外部温度と、炉壁に設置された温度 ンサにより側定された炉壁温度およびカス 健 横情報等を用いて、 被加熱物の内部 高度 を進せ し、 骸椎定値と、 予め与えられている 被加熱物 の目標温度との形にもとづき、 目標温度 関い けるように、 ヒータヤカス焼入 は等の制御設定 でを決定することを特徴とする炉内温度オンライン オン財側・制御方式。
- 2 加熱炉内における被加熱物の内部温度の目標 追値制御方式において、診加熱炉の炉壁を炉棚 方向にゾーン分削し、該炉壁の温度より上記被 加熱物の炉軸方向温度分布を推定する非線化モ

デル方程式及び、該推定値と目標値との差を評価 する評価関数にもとづき、 該評価関数が兼小に なるように炉蟹温度を決定することを特徴とす る炉内温度オンライン計測・制御方式。

### 発明の詳細な説明

#### (発明の利用分野)

本発明は半導体の酸化・拡散炉およびCVD炉、 鉄鋼の高炉、ガラスの溶解炉、紙の蒸解釜、化学 関連の反応炉等の制御方式に関し、特に炉内にお かれた被加熱物の内部温度分布のオンライン計削 方法および炉の制御方式に関する。

### 〔従来技術〕

従来、炉内の温度分布を制御するために

- (1) 外壁温度予測による制御
- (前) 高炉等の目視による制御

などの方法がおこなわれていた。

(i)は炉外襞の低度を実制し、この実測値にもとづき炉内の温度分布を予測しては所望の制御をおこなう方法であり、(iii)は高炉内を目視し火炎の色などから炉内の温度分布を予測しては所望の制御

### 特開明59-108119 (2)

7

をおこなり方法であるが、いずれも過去の経験などにもとづく為とノワハウに頼るため精緻な炉制 御が不可能であつた。

例えば、拡散炉内のウェハを設計で定められた 温度でウエハ全体を均一に拡散するための拡散炉 の温度制御をおとなり場合に、従来の拡散炉は、 炉壁面全体が一定温度になるように制御されてい たが、ウエハ目体の温度測定法が無いためウエハ **艦度がほとんど分つていなかつた。ウエハ付近に** 虚度センサを装備すると注入されるガスが乱旒状 態となり、ウエハ島度の均一性を描う事になるた め、センサによる炉心部での温度測定を避けなけ ればならない。とのような理由から炉壁温度より 炉内部のウエハ温度を推定することのできるモデ ルの開発が要求される。従来のように拡散炉の炉 襞を一定温度に加熱する方法によると、ウエハの 位置により協度が異なり最終的に完成した半導体 特性のはらつきを生じ、歩留りを減少させる結果 となる欠点を持つ。

#### 〔発明の目的〕

101の適当な場所に怒1030,103~106 (窓の個数および形状は、炉の大きさや制御方式 によつて異なる)を設け、この窓の位置にITV (工業テレビ)107~111を設備する。との ITVにより、炉内の温度分布情報112~116 を画像処理装置117に送る。との画像処理装置 117には、超高速パイプラインプロセツサ等に よる高速貨算機能や、大容量のリフレツシュメモ り機能を有し、高度な画像処理をリアルタイムで 処理できる機能を具備している。この装置117 により、炉内の被対象物の外部温度(但し、ITV から見える範囲の空間)をその熱スペクトル解析 により推定し、その協度推定情報118を勘度変 終計算装置119に入力する。とこで、各JTV からの協関推定情報を、制御モデルに必要な入力 情報(たとえば、各ITVの温度分布情報を平均 化し平均化温度/ITV)とする。との温度入力 情報120を制御モデル計算装置121に入力す る。ととでは、被加熱物(ウエハ102)温度分 布推定モデルを用い、入力した磁度入力情報 120 本発明の目的は、炉内の被加熱物の内部處度分布を、目標處度分布に近づけて運転できるように するための、炉内温度分布のオンライン計測方法 および炉を精緻に制御する方式を提供することに ある。

#### 〔発明の概要〕

炉内温度は高温(たとえば、1000で)のため、耐久性等の問題から通常のセンサ(たとえば熱電対等)を炉内のオンライン計側に利用することはできない。そこで、本発明では炉の適当な位置に窓(現状でも設置されているようなのぞき窓のようなもの)を設け、そこにITV(工業テレビ)を複数台設置し、このITVからの画像情報をもとに、画像処理装蔵を用いて炉内の温度を推定し、この推定値を制御モデルに入力することにより、炉内の扱加熱物の内部温度を目標温度に近づけて運転する点に特敵がある。

#### (発明の実施例)

第1図は本発明による半導体の酸化・拡散炉の 第1の実施例の構成を示す。第1図において、炉

を境界値(実測値)として、炉内全ウェハ102のウェハ面内温度分布を計算により求める。計算法はウェハ温度、ガス温度、およびガス流速に対する熱硫体方程式をモデル化し、温度入力情報120を境界値とし、また、その時の硫入ガス流量122をガス流量計123から、炉機温度124~126を温度計127~129から計測し、これらのデータに基づいて、各ウェハ面内の温度分布を推定計算する。このとき、下記の評価式

**にかいて、Jが** 

-120-

### 特開昭59-108119 (3)

の評価内に入つているかどうか判定する。もし、入つていれば、現状の制御を継続する。もし、入つていなければ、(I)式のJを最小にするように最適計算を行ない、ガス制御目標値130、ヒータ加熱目標値131~133を求める。これらの目標値はPID制御接置として公知のフィードパック制御装置134~137に入力され、炉がオンライン制御される。

つぎに、本発明による第2の実施例にもとづき、 加熱炉内の温度が側定不可能なとき、炉壁温度を 一定にするだけでは被加熱物が不均一に加熱され るという欠点を改善するために、炉内部状態を推 定するモデルに基づき、加熱炉壁の温度を例えば 炉照に装備されたヒータで調整する事により被加 熱物を均一温度で加熱するように制御する手順に ついて併細に説明する。

第2図は本発明による拡散炉の第2の実施例の 構成と、その温度制御装置との接続関係の一例を 示す。第2図において、対象とする拡散炉101 は円筒型のチューブでウエハ102はその中央部

次に、炉蟹温度を設定する手軽について脱明する。 i 番目のウェハ温度をTi, i 番目の両鱗りのウェハ温度をTi(j=i±1)、炉壁温度をTF,シリコンの熱伝導率をKw,吸収率をa,ウェハ間の形態係数をG。,ウェハと炉壁との形態係数をF。とするとi番目のウェハ温度Tiは次の熱方程式を解く事により得られる。

(1)式において、第2項は両隔りのウェハ(その 表面積をA」とする)からの輻射を裂わし、第3 項は炉壁(その長面積をFとする)からの輻射を 示す第3項に対して次のような近似を行なう。 ウェハ協成T」( → ′ ′ , t )が位置 → ′ ′ に対してそれ

のポート 2020 に乗せられて炉1 0 1 内へ搬送さ れ拡散され再び炉201外へ出て行く。問題とな るのは拡散中の炉軸(2軸)方向の炉内の温度分 布の推定である。ポート中央部にあるウェハは両 難りのウェハからの直接輻射及び炉甓からの直接 輻射により加熱されるので中央部のウェハは両端 部のウエハより高温になるものと推定される。従 つてウエハを均一温度で拡散するための拡散炉の 温度制御は以下のようにして行なわれる。ます初 期入力として、たとえば、ウエハの設計(目原) 温度T を破適計算装置206に入力し、後述す る計算方法によりウェハをヒータ203、204 および205で均一加熱するような対称3ソーン の炉機温度を決定する。炉機温度が決定されると、 センサ208の炉蟹温度測定結果と上記最適計算 装置 6 で決定された炉競温度との差分を減算器 200で計算してこの差分に基づき、 PIDコン トローラ207を用いる串により、電源209を 調整し、前記ヒータ203。204および205 により所定の温度に加熱する。

ほど変化しないとしてT」( r', t)をT」( r, t)で置き換えて積分配号の外に出す。 G。( r, r')は r=r'の時に最大値を取るような関数であり、それ以外の r'に対しては | r-r'| 0の4乗に逆比例して小さくなるのでこの近似が可能となる。このような近似に対して(1)式は次のように書く事ができる。

$$\frac{\partial \mathbf{T}_{1}}{\partial t} = -2\mathbf{T}_{1}^{4} + \mathbf{a} \left( \mathbf{T}_{-1}^{4} + \mathbf{T}_{1}^{4} \right) \mathbf{g} \left( \mathbf{r} \right) + \mathbf{a} \mathbf{T}_{1}^{4} \mathbf{f} \left( \mathbf{r} \right) + \mathbf{K}_{1} \mathbf{w} \left( \mathbf{T}_{1} \right) \mathbf{V}_{2}^{2} \mathbf{T}_{1} \cdots (2)$$

$$\mathbf{C} \mathbf{C} \mathbf{T} \mathbf{V}_{1}^{2} = \frac{\partial^{2}}{\partial \mathbf{r}^{2}} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}}$$

(2)式を両端のウェハ、中間部のウェハに分けて 要わすと次のようになる。

$$\frac{\partial T_{i}}{\partial t} = -2T_{i}^{4} + aT_{i}^{4} + Kw(T_{i})V_{i}^{2}T_{i}$$

$$\frac{\partial T_{i}}{\partial t} = -2T_{i}^{4} + a(T_{i-1}^{4} + T_{i+1}^{4})g(r) + Kw(T_{i})V_{i}^{2}T_{i} + KT_{i}^{4} (i = 2, 3 \dots N) \dots (3)$$

ここで、KTP\*は炉壁からの輻射を装わす項である。今、定常状態でのウェハ塩度に着目しウェハ間での温度変動を調べるため拡散項を省略する。

$$-2 T_{1}^{4} + a T_{7}^{4} = 0$$

$$-2 T_{1}^{4} + a (T_{1}^{4} + T_{1}^{4}) g(r) + K = 0$$

$$(i = 2, 3, ..., N)$$

$$-2 T_{N}^{4} + a T_{7}^{4} = 0$$
......(4)

$$T^{4}_{I-1} = \{ T(Z) - \frac{\partial T(Z)}{\partial Z} + \frac{1}{2} \frac{\partial^{2} T(Z)}{\partial Z^{2}} \dots \}^{4}$$

$$= T^{4} - 4 T^{3} \frac{\partial T}{\partial Z} + 2 T^{3} \frac{\partial^{2} T}{\partial Z^{2}} \dots (5)$$

$$\mathbf{T^{4}}_{1*_{1}} = \left\{ \mathbf{T} \left( \mathbf{Z} \right) \right. + \frac{\partial \mathbf{T} \left( \mathbf{Z} \right)}{\partial \mathbf{Z}} + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^{2} \mathbf{T} \left( \mathbf{Z} \right)}{\partial \mathbf{Z}^{2}} \cdots \right. \right\}^{4}$$

蟹温度TFを唯一の操作量として、炉蟹風度の両端部を中間部より高温にしてウェハ間の温度差を 最小にするような制御方法を取る事である。この アルゴリズムを実現するため次の評価関数を導入 する。

$$J = \int_{0}^{L_{0}} (T(Z) - T^{\bullet})^{2} dZ \rightarrow m$$
 ..... (9)

CCでT <sup>\*</sup> はウェハの段射臨度である。今、拡散炉 が対称な 3 ゾーン方式により個度制御されている としてT (2) は次のようになる。

$$T (Z) = \begin{cases} T_0 : 0 \le Z \le \mathcal{L} \\ T_L : \mathcal{L} \le Z \le L_0 - \mathcal{L} & \cdots \end{cases} (10)$$

$$T_0 : L = \mathcal{L} \le Z \le L_0$$

(8)式, (10)式を(9)式に代入しTo, Toについて それぞれJを変分し0と置く事により次式を得る。

$$T_{\sigma} = \frac{\frac{2k}{k^{2}}(X+X') - (Y+Y')}{2(\frac{a}{2})^{\frac{1}{4}}(X+X')}$$

特開昭59-108119 (4)

$$= T^4 + 4 T^3 \frac{\partial T}{\partial Z} + 2 T^3 \frac{\partial^2 T}{\partial Z^2} \cdots (6)$$

(5), (6)式を(4)式の第2式に代入して2に関して2回像分までとり、K, を温度依存性の非常に小さい定数として整理すると近似的に次式のようにむける。

$$\frac{\partial^2 T}{\partial Z^2} = -\frac{1}{2} \frac{1 - ag}{ag} T = -K'TF \quad \cdots \qquad (7)$$

(4)式の第1.第3式の境界条件式を用いる事により(7)式の解は、

$$T(Z) = \frac{\left(\frac{a}{2}\right)^{\frac{1}{4}} T_{0} - \frac{K}{k^{2}}}{e^{\frac{1}{k}L_{0}} - e^{-\frac{1}{k}L_{0}}} ((1 - e^{-\frac{1}{k}L_{0}}) e^{\frac{1}{k^{2}}} + (e^{\frac{1}{k}L_{0}} - 1) e^{-\frac{1}{k^{2}}}) + \frac{K'}{k^{2}} T_{F} \cdots (8)$$

$$CCT k = \sqrt{\frac{1-ag}{ag}}$$

となる。(8)式によつて炭わされる2軸方向の虚歴 分布の大体の様子を第3図に示す。このように両 端部に近いウェハは中間部のウエハより低温とな る。しかるにウェハ間温度均一化制御の方法は炉

222

$$X = \frac{A^2}{2 k} (2^{2kL} - 1) + \frac{B^2}{2 h} (1 - e^{-2kL}) + 2ABL$$

$$X' = \frac{A^{2}}{2k} \left( e^{2kL_{B}} - e^{2k(L_{B}-2)} \right) + \frac{B^{2}}{2k} \left( e^{-2k(L_{B}-2)} - e^{-2kL_{B}} \right) + 2ABC$$

$$Y = (\frac{2 K' T_F}{k^3} - \frac{2 T}{k}) (\Lambda e^{k L} - B e^{-k L} - A + B)$$

$$Y' = (\frac{2K'T_F}{k^3} - \frac{2T^*}{k})(Ae^{kL_B} - Be^{-kL_B})$$

$$-A e^{k(L_B-2)} + B e^{-k(L_B-2)}$$

$$X'' = \frac{\Lambda^{2}}{2 k} \left( e^{2k (L_{B} - L)} - e^{2k L} \right) + \frac{B^{2}}{2 k} \left( e^{-k L} - e^{2k (L_{B} - L)} \right) + 2 AB L_{B} - 4 AB L$$

$$Y'' = \left(\frac{2K'T_F}{k^2} - \frac{2T}{k}^4\right) \left(A e^{k(L_B - L)} + B e^{-k(L_B - L)}\right)$$
$$-A e^{kL} + B e^{-kL}$$

特開昭59-108119 (5)

さらに

$$A = \frac{1 - e^{-kL_B}}{e^{kL_B} - e^{-kL_B}} , B = \frac{e^{kL_B} - 1}{e^{kL_B} - e^{-kL_B}}$$

である。 Tェ 及び T n の大体の機子を第 4 図に示 す。(11)式によりウエハが均一加熱されるような 3 ゾーンの炉壁温度が決定された訳であるが、と とで注意しなければならない事は炉漿温度を変え る事により(7)式の右辺は変化する事である。故に 再び(8)式に戻り(9)式の評価関数を最小化するよう 左To 及びTu を財算するというアルゴリズムを はり返して最適な炉號温度To TL を得る事 ができる。第5図は上記のアルゴリズムを示す。 第5図におけるそれぞれのステップでは次の処理 を行なう。

ステップ401:初期入力として、たとえば目標 の設計品度丁。を破過計算装置 206に入力する。

ステップ102:(8)式によりウェハ間温度分布を

ステップ 4 0 3 : (11) 式より対称 3 ソーンの各々

2の実施例に示した方式によれば拡散炉内のウェ へを均一加熱するような炉壁温度の制御方式にお いて、熱方程式を基化作成したモデルと評価関数 を用いて、該評価関数が最小となるように炉整温 度を操作するようにしたので最適な炉壁温度を決 定する事ができ、半導体特性のバラツキを低減し 歩留りを向上させる事が可能となる。これにより 高性能の半導体を安定に製造する事が可能になり その経済的効果は大きい。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明による拡散炉の第1の実施例の 構成図、第2図は本発明による拡散炉の第2の実 施例の構成図、第3図は炉壁を均一加熱した際の ウエハ間温度分布を示し、第4関は3ゾーン方式 による炉鉄以底分布を示し、第5回は制御のアル ゴリズムのフローチャートを示す。

101…拡散炉、102…ウェハ。

代理人 弁理士 奪田利幸 你起



ステップ404; T v 。 T L を用い再び(8)式によ

の温度To,TLを計算する。

り丁(乙)を計算する。

ステップ405:評価関数を競小化するTu, T. かどうかを判定し、真(Y) ならTuをTo。TuをTu。 としTu とTL をヒータの低 顔にセツトする。偽(N)左ら ステップ402亿戻りアルゴリ メムを繰り返す。

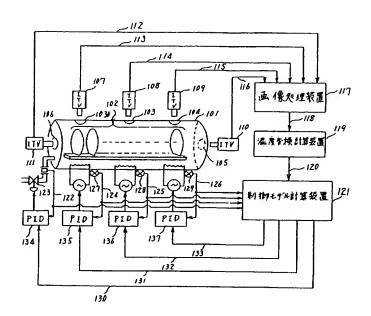
#### 〔発明の効果〕

本発明によれば、炉内の被加熱物の外部温度が 画像処理技術により明らかとなり、更に、この温 度推定値を用いて、世加熱物の内部単度をモデル により推定することができ、この内部温度を目標 値に近づけるように、投入ガス流量。ヒータ加熱 温度等の散定値を決めることができるから、これ まで勘とノウハウに頼つていた炉制御を、オンラ イン計測に基づく閉ループ制御とすることができ、 歩留り向上に大きな効果が期待できる。また、第

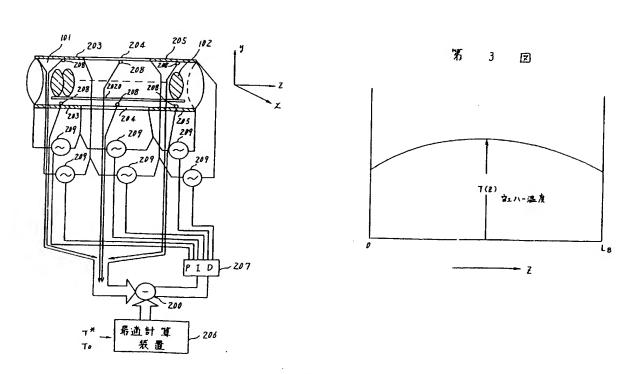
# 特開昭59-108119(6)

第1回

测·制御方式



第 2 図



-124-

### 特開昭59-108119 (フ)

